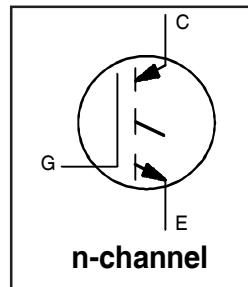


# IRG4BC30SPbF

Standard Speed IGBT

## Features

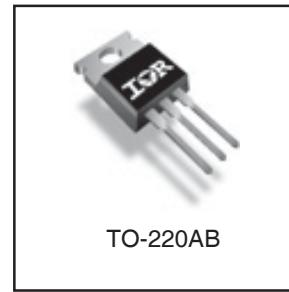
- Standard: optimized for minimum saturation voltage and low operating frequencies ( $< 1\text{kHz}$ )
- Generation 4 IGBT design provides tighter parameter distribution and higher efficiency than Generation 3
- Industry standard TO-220AB package
- Lead-Free



$V_{CES} = 600\text{V}$
$V_{CE(\text{on}) \text{ typ.}} = 1.4\text{V}$
@ $V_{GE} = 15\text{V}$ , $I_C = 18\text{A}$

## Benefits

- Generation 4 IGBTs offer highest efficiency available
- IGBTs optimized for specified application conditions
- Designed to be a "drop-in" replacement for equivalent industry-standard Generation 3 IR IGBTs



## Absolute Maximum Ratings

	Parameter	Max.	Units
$V_{CES}$	Collector-to-Emitter Breakdown Voltage	600	V
$I_C @ T_C = 25^\circ\text{C}$	Continuous Collector Current	34	A
$I_C @ T_C = 100^\circ\text{C}$	Continuous Collector Current	18	
$I_{CM}$	Pulsed Collector Current ①	68	
$I_{LM}$	Clamped Inductive Load Current ②	68	
$V_{GE}$	Gate-to-Emitter Voltage	$\pm 20$	V
$E_{ARV}$	Reverse Voltage Avalanche Energy ③	10	mJ
$P_D @ T_C = 25^\circ\text{C}$	Maximum Power Dissipation	100	W
$P_D @ T_C = 100^\circ\text{C}$	Maximum Power Dissipation	42	
$T_J$ $T_{STG}$	Operating Junction and Storage Temperature Range	-55 to + 150	$^\circ\text{C}$
	Soldering Temperature, for 10 seconds	300 (0.063 in. (1.6mm) from case)	
	Mounting torque, 6-32 or M3 screw.	10 lbf-in (1.1N·m)	

## Thermal Resistance

	Parameter	Typ.	Max.	Units
$R_{\theta JC}$	Junction-to-Case	---	1.2	$^\circ\text{C/W}$
$R_{\theta CS}$	Case-to-Sink, Flat, Greased Surface	0.50	---	
$R_{\theta JA}$	Junction-to-Ambient, typical socket mount	---	80	
Wt	Weight	2.0 (0.07)	---	g (oz)

# IRG4BC30SPbF

International  
**IR** Rectifier

## Electrical Characteristics @ $T_J = 25^\circ\text{C}$ (unless otherwise specified)

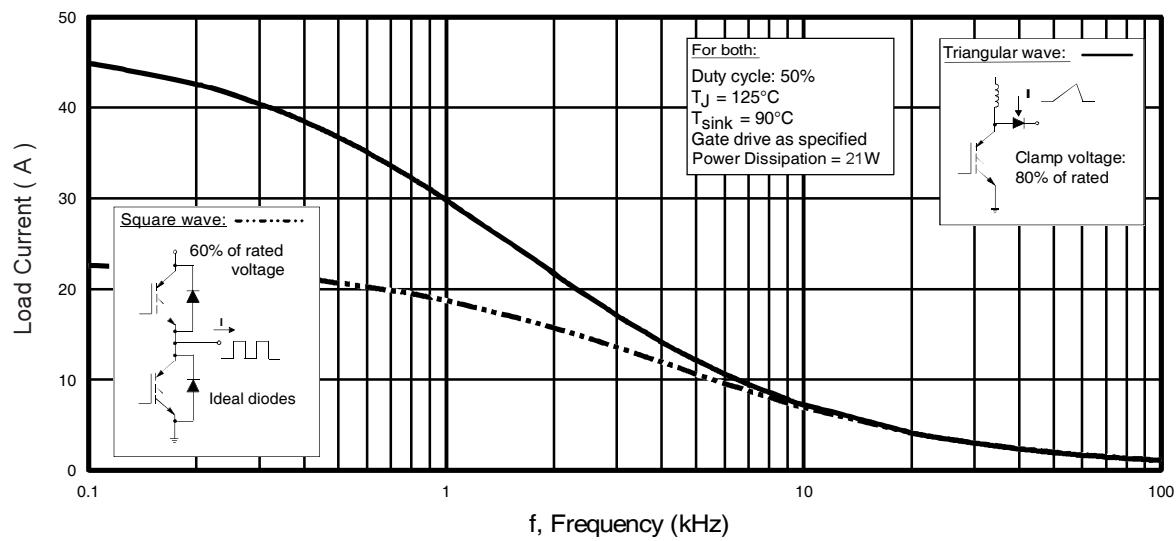
	Parameter	Min.	Typ.	Max.	Units	Conditions
$V_{(\text{BR})\text{CES}}$	Collector-to-Emitter Breakdown Voltage	600	—	—	V	$V_{\text{GE}} = 0\text{V}, I_C = 250\mu\text{A}$
$V_{(\text{BR})\text{ECS}}$	Emitter-to-Collector Breakdown Voltage ④	18	—	—	V	$V_{\text{GE}} = 0\text{V}, I_C = 1.0\text{A}$
$\Delta V_{(\text{BR})\text{CES}/\Delta T_J}$	Temperature Coeff. of Breakdown Voltage	—	0.75	—	$\text{V}/^\circ\text{C}$	$V_{\text{GE}} = 0\text{V}, I_C = 1.0\text{mA}$
$V_{\text{CE}(\text{ON})}$	Collector-to-Emitter Saturation Voltage	—	1.40	1.6	V	$I_C = 18\text{A}$
		—	1.84	—		$I_C = 34\text{A}$
		—	1.45	—		$I_C = 18\text{A}, T_J = 150^\circ\text{C}$
$V_{\text{GE}(\text{th})}$	Gate Threshold Voltage	3.0	—	6.0		$V_{\text{CE}} = V_{\text{GE}}, I_C = 250\mu\text{A}$
$\Delta V_{\text{GE}(\text{th})/\Delta T_J}$	Temperature Coeff. of Threshold Voltage	—	-11	—	$\text{mV}/^\circ\text{C}$	$V_{\text{CE}} = V_{\text{GE}}, I_C = 250\mu\text{A}$
$g_{\text{fe}}$	Forward Transconductance ⑤	6.0	11	—	S	$V_{\text{CE}} = 100\text{V}, I_C = 18\text{A}$
$I_{\text{CES}}$	Zero Gate Voltage Collector Current	—	—	250	$\mu\text{A}$	$V_{\text{GE}} = 0\text{V}, V_{\text{CE}} = 600\text{V}$
		—	—	2.0		$V_{\text{GE}} = 0\text{V}, V_{\text{CE}} = 10\text{V}, T_J = 25^\circ\text{C}$
		—	—	1000		$V_{\text{GE}} = 0\text{V}, V_{\text{CE}} = 600\text{V}, T_J = 150^\circ\text{C}$
$I_{\text{GES}}$	Gate-to-Emitter Leakage Current	—	—	$\pm 100$	nA	$V_{\text{GE}} = \pm 20\text{V}$

## Switching Characteristics @ $T_J = 25^\circ\text{C}$ (unless otherwise specified)

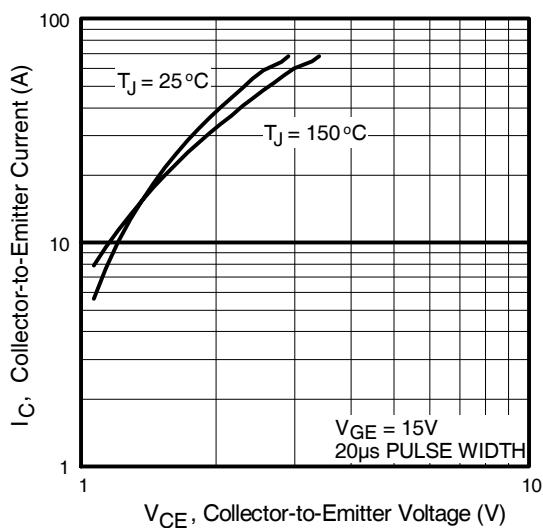
	Parameter	Min.	Typ.	Max.	Units	Conditions
$Q_g$	Total Gate Charge (turn-on)	—	50	75	nC	$I_C = 18\text{A}$
$Q_{ge}$	Gate - Emitter Charge (turn-on)	—	7.3	11		$V_{\text{CC}} = 400\text{V}$
$Q_{gc}$	Gate - Collector Charge (turn-on)	—	17	26		$V_{\text{GE}} = 15\text{V}$
$t_{d(\text{on})}$	Turn-On Delay Time	—	22	—	ns	$T_J = 25^\circ\text{C}$ $I_C = 18\text{A}, V_{\text{CC}} = 480\text{V}$ $V_{\text{GE}} = 15\text{V}, R_G = 23\Omega$
$t_r$	Rise Time	—	18	—		
$t_{d(\text{off})}$	Turn-Off Delay Time	—	540	810		
$t_f$	Fall Time	—	390	590		
$E_{\text{on}}$	Turn-On Switching Loss	—	0.26	—	mJ	Energy losses include "tail" See Fig. 9, 10, 14
$E_{\text{off}}$	Turn-Off Switching Loss	—	3.45	—		
$E_{ts}$	Total Switching Loss	—	3.71	5.6		
$t_{d(\text{on})}$	Turn-On Delay Time	—	21	—	ns	$T_J = 150^\circ\text{C},$ $I_C = 18\text{A}, V_{\text{CC}} = 480\text{V}$ $V_{\text{GE}} = 15\text{V}, R_G = 23\Omega$
$t_r$	Rise Time	—	19	—		
$t_{d(\text{off})}$	Turn-Off Delay Time	—	790	—		
$t_f$	Fall Time	—	760	—		
$E_{ts}$	Total Switching Loss	—	6.55	—	mJ	Energy losses include "tail" See Fig. 11, 14
$L_E$	Internal Emitter Inductance	—	7.5	—	nH	Measured 5mm from package
$C_{\text{ies}}$	Input Capacitance	—	1100	—	pF	$V_{\text{GE}} = 0\text{V}$ $V_{\text{CC}} = 30\text{V}$ $f = 1.0\text{MHz}$
$C_{\text{oes}}$	Output Capacitance	—	72	—		
$C_{\text{res}}$	Reverse Transfer Capacitance	—	13	—		

### Notes:

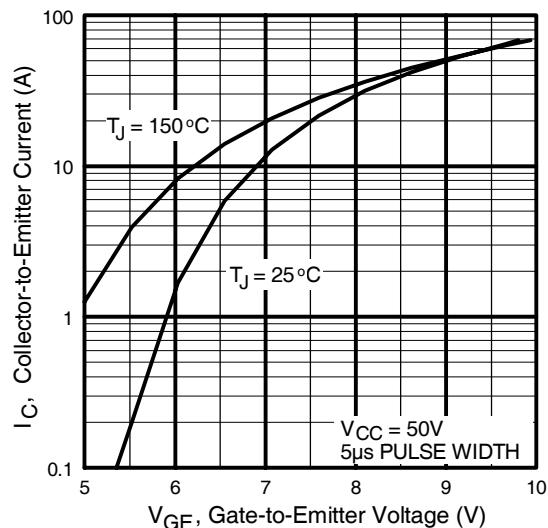
- ① Repetitive rating;  $V_{\text{GE}} = 20\text{V}$ , pulse width limited by max. junction temperature. ( See fig. 13b )
- ②  $V_{\text{CC}} = 80\%(V_{\text{CES}})$ ,  $V_{\text{GE}} = 20\text{V}$ ,  $L = 10\mu\text{H}$ ,  $R_G = 23\Omega$ , ( See fig. 13a )
- ③ Repetitive rating; pulse width limited by maximum junction temperature.
- ④ Pulse width  $\leq 80\mu\text{s}$ ; duty factor  $\leq 0.1\%$ .
- ⑤ Pulse width  $5.0\mu\text{s}$ , single shot.



**Fig. 1 - Typical Load Current vs. Frequency**  
 (Load Current =  $I_{RMS}$  of fundamental)



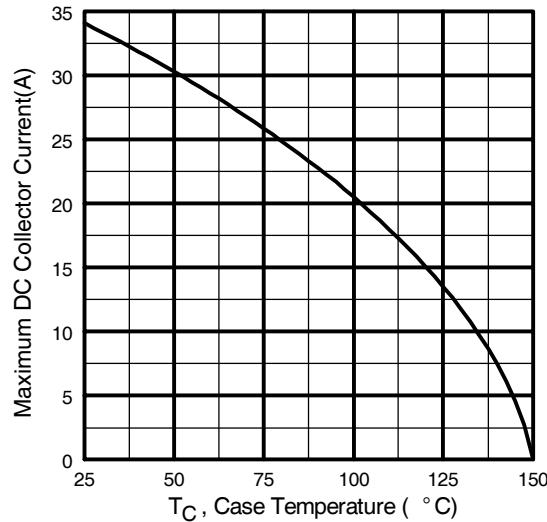
**Fig. 2 - Typical Output Characteristics**



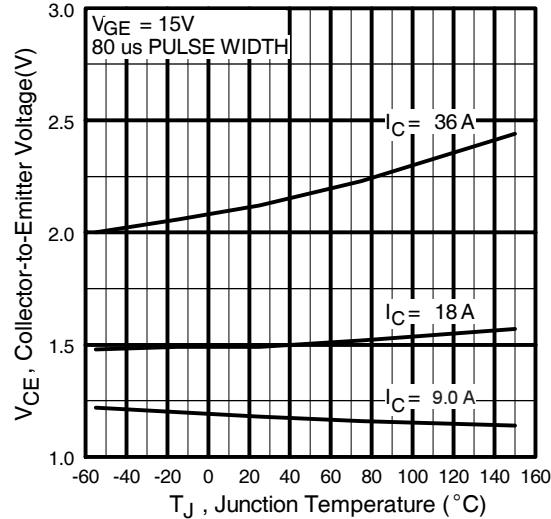
**Fig. 3 - Typical Transfer Characteristics**

# IRG4BC30SPbF

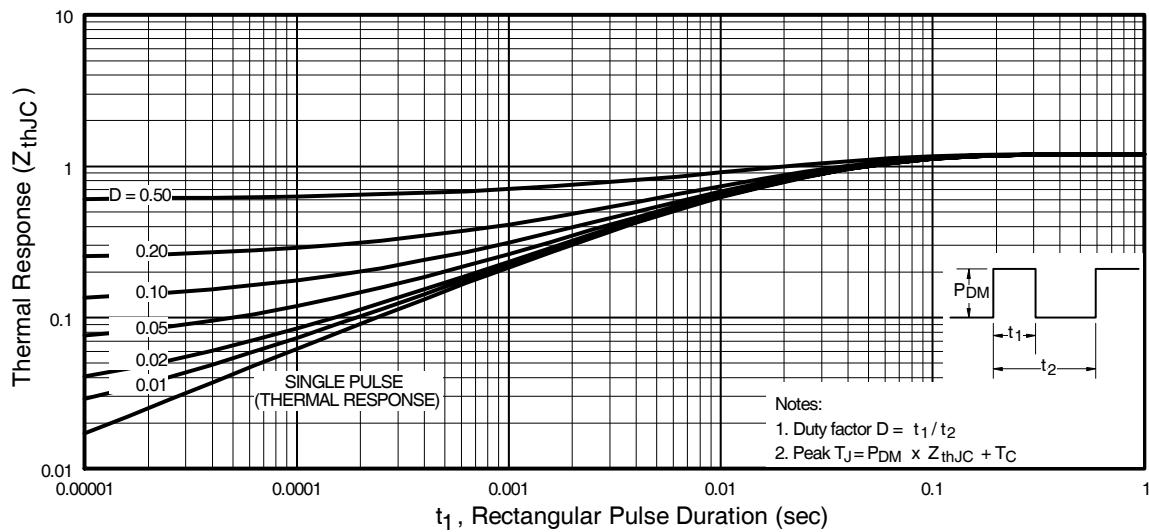
International  
**IR** Rectifier



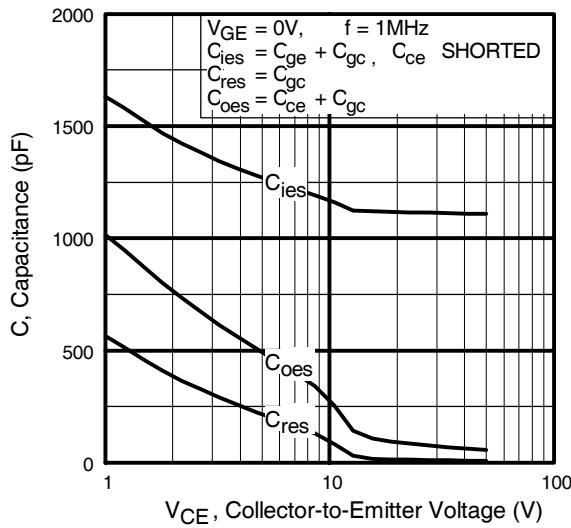
**Fig. 4 - Maximum Collector Current vs. Case Temperature**



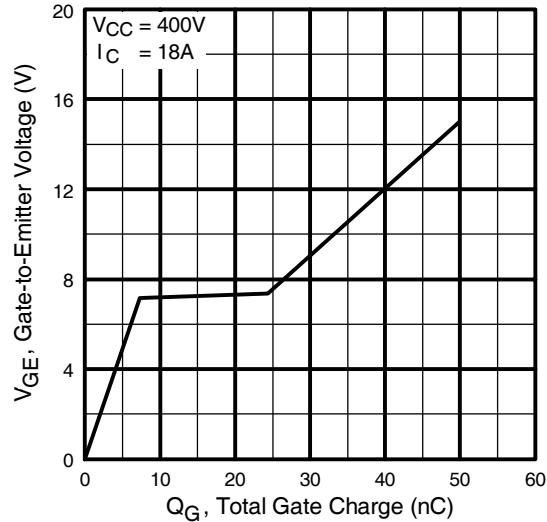
**Fig. 5 - Typical Collector-to-Emitter Voltage vs. Junction Temperature**



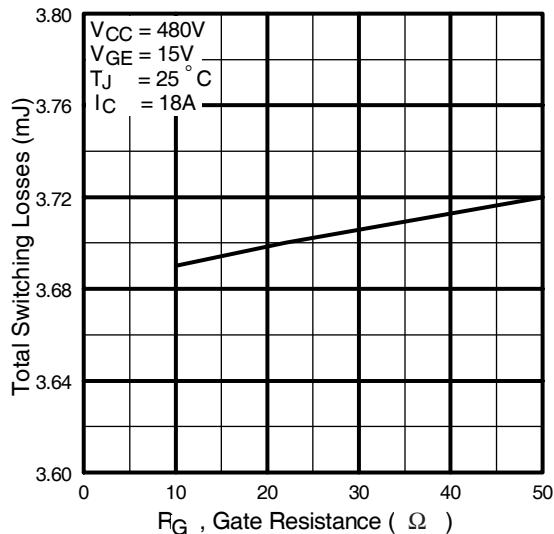
**Fig. 6 - Maximum Effective Transient Thermal Impedance, Junction-to-Case**



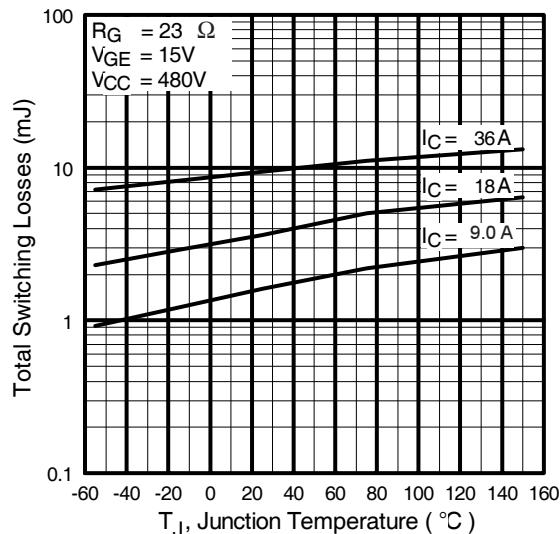
**Fig. 7 - Typical Capacitance vs.  
Collector-to-Emitter Voltage**



**Fig. 8 - Typical Gate Charge vs.  
Gate-to-Emitter Voltage**



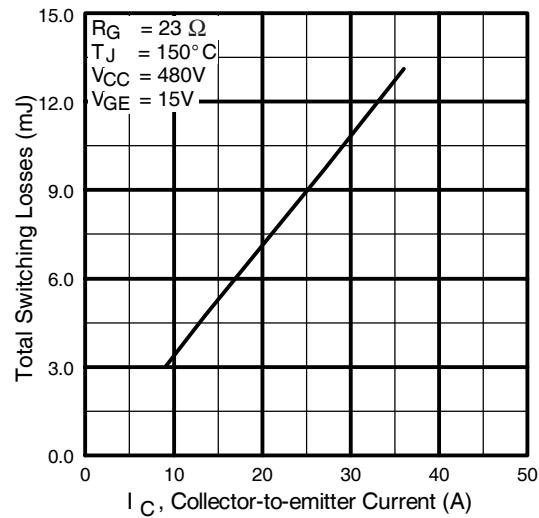
**Fig. 9 - Typical Switching Losses vs. Gate  
Resistance**



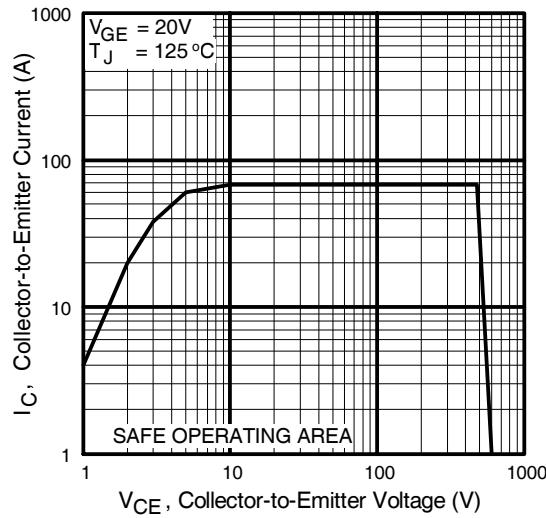
**Fig. 10 - Typical Switching Losses vs.  
Junction Temperature**

# IRG4BC30SPbF

International  
**IR** Rectifier

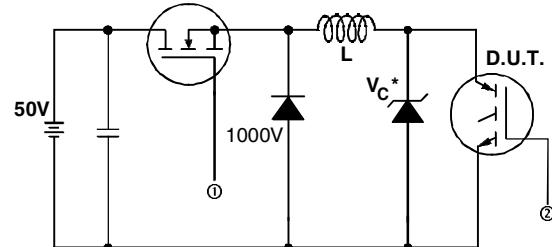


**Fig. 11 - Typical Switching Losses vs.  
Collector-to-Emitter Current**



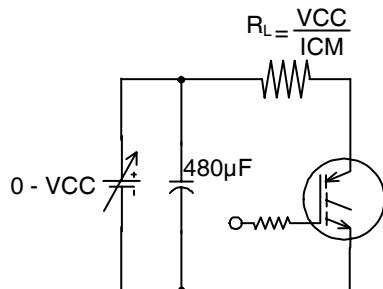
**Fig. 12 - Turn-Off SOA**

## IRG4BC30SPbF



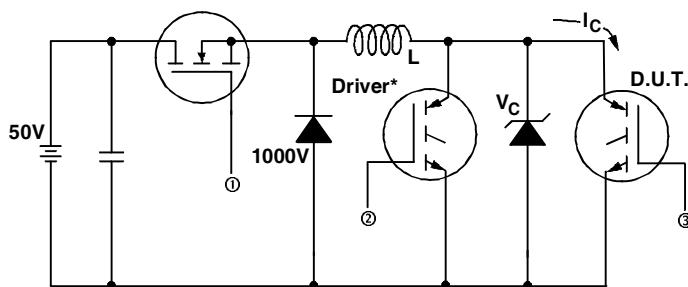
\* Driver same type as D.U.T.;  $V_C = 80\%$  of  $V_{ce(max)}$   
 \* Note: Due to the 50V power supply, pulse width and inductor will increase to obtain rated  $I_d$ .

**Fig. 13a** - Clamped Inductive Load Test Circuit



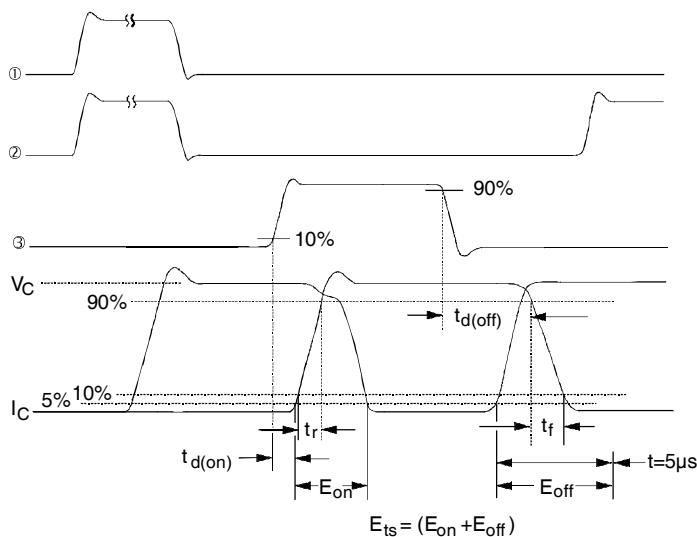
Pulsed Collector Current Test Circuit

**Fig. 13b** - Pulsed Collector Current Test Circuit



**Fig. 14a** - Switching Loss Test Circuit

\* Driver same type as D.U.T.,  $V_C = 480V$

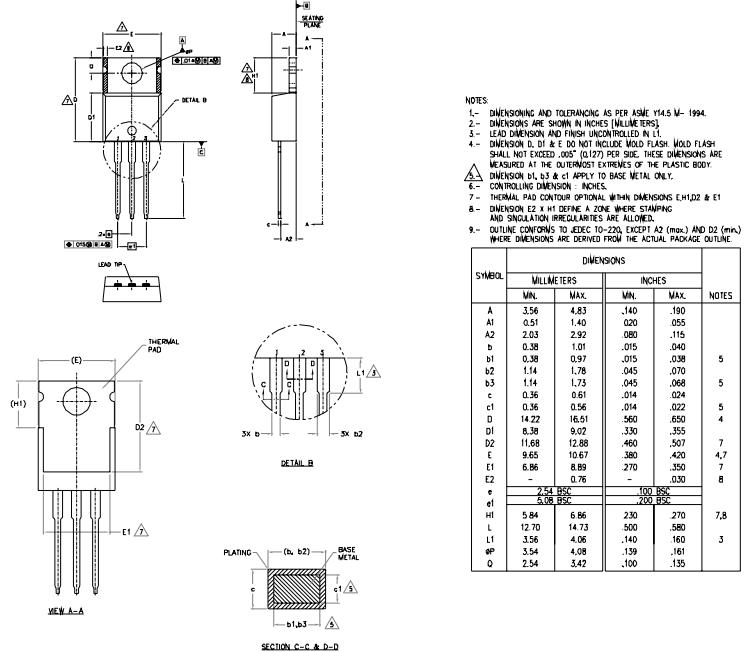


**Fig. 14b** - Switching Loss Waveforms

# IRG4BC30SPbF

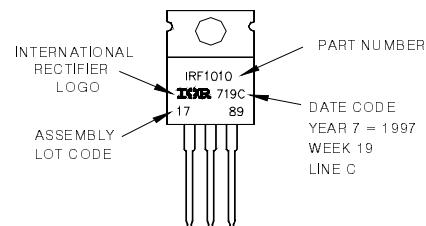
International  
**IR** Rectifier

## TO-220AB Package Outline (Dimensions are shown in millimeters (inches))



## TO-220AB Part Marking Information

EXAMPLE: THIS IS AN IRF1010  
LOT CODE 1789  
ASSEMBLED ON WW 19, 1997  
IN THE ASSEMBLY LINE "C"  
Note: "P" in assembly line  
position indicates "Lead-Free"



Note: For the most current drawing please refer to IR website at <http://www.irf.com/package/>

Data and specifications subject to change without notice.

International  
**IR** Rectifier

**IR WORLD HEADQUARTERS:** 233 Kansas St., El Segundo, California 90245, USA Tel: (310) 252-7105  
TAC Fax: (310) 252-7903

Visit us at [www.irf.com](http://www.irf.com) for sales contact information. 01/2010



# OCEAN CHIPS

## Океан Электроники

### Поставка электронных компонентов

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

#### Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибутором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибутором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А